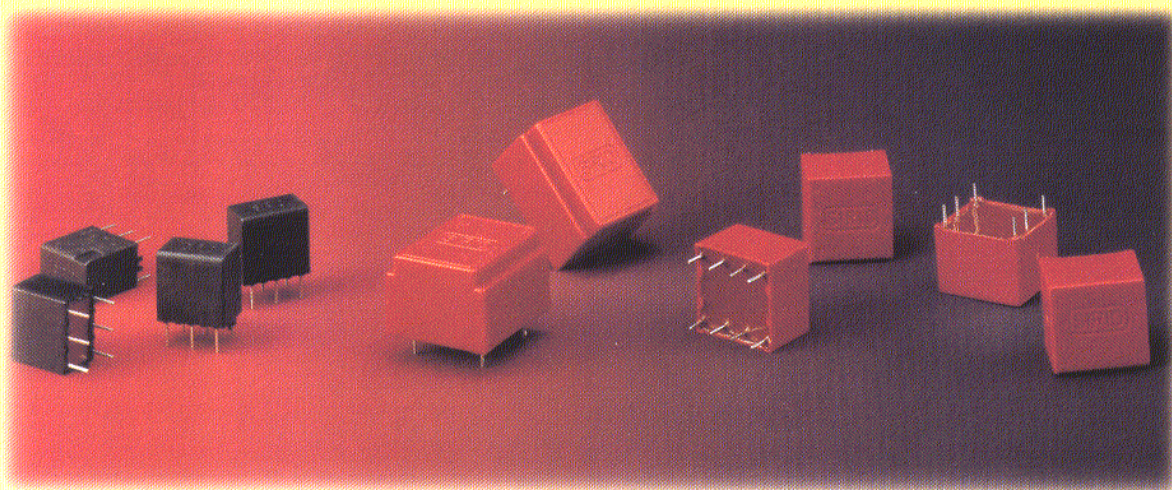


SIRIO

Inductive
Components



Drive Transformers

Drive Transformers



Nel presente catalogo vengono presentate alcune serie di trasformatori adatti al pilotaggio di MOSFET, IGBT e TRANSISTOR ad alta frequenza.

Tuttavia, poiché le tecniche di pilotaggio sono diverse, siamo anche in grado di costruire componenti su specifica richiesta del cliente: a tale scopo è necessario compilare il foglio richiesta dati.



Dans ce catalogue, nous vous présentons nos nouvelles séries de transformateurs pour les commandes de composants MOSFET, IGBT, et TRANSISTOR à des fréquences élevées.

Cependant, compte tenu des différentes techniques de commandes, nous pouvons également développer des transformateurs adaptés à vos spécifications. Nous vous recommandons, dans ce cas, d'utiliser la feuille jointe.



In this catalogue we introduce you new series of transformers suitable to drive high frequency MOSFETS, IGBTs and TRANSISTORS.

Nevertheless, owing to the different driving techniques, we are also able to develop transformers following your specific requirements: for this, it is required to fill the enclosed sheet.



En este catálogo presentamos algunas series de transformadores apropiados para control de MOSFET, IGBT y TRANSISTORES de alta frecuencia.

Por otra parte, debido a las distintas técnicas de control, podemos desarrollar transformadores siguiendo las especificaciones del cliente: para lo cual es necesario rellenar la hoja de especificaciones adjunta.



In diesem Katalog stellen wir eine neue Serie von Transformatoren vor, die für die Ansteuerung schneller MOSFETS, IGBTs und TRANSISTOREN geeignet sind.

Bedingt durch die unterschiedlichen Ansteuertechniken bieten wir die Entwicklung anwendungsspezifischer Spezialtransformatoren auf der Basis Ihrer Anforderungen an. Bitte füllen Sie dazu das beigefügte Spezifikationsblatt aus und senden Sie uns dieses zu.

n Rapporto spire
Lp Induttanza primaria
Ck Capacità di accoppiamento tra primario e secondari in serie
Ls Induttanza dispersa al primario con i secondari in corto circuito
Rp/Rs Resistenza degli avvolgimenti
Uis Tensione di lavoro
Up Tensione di prova
J_{udt} Area minima di «tensione-tempo» trasferibile al secondario nel caso di impulsi unipolari.

n Rapport de spires
Lp Inductance primaire
Ck Capacité de couplage entre primaire et secondaires couplés ensemble
Ls Inductance de fuite au primaire avec court-circuit des secondaires
Rp/Rs Résistance des enroulements
Uis Tension d'utilisation
Up Tension d'essai
J_{udt} Aire minimale «tension-temps» pouvant être transférée au secondaire dans le cas d'impulsions unipolaires.

n Turns ratio
Lp Primary inductance
Ck Coupling capacity between primary and secondaries connected together
Ls Leakage inductance at primary with secondaries in short circuit
Rp/Rs Windings resistance
Uis Working voltage
Up Test voltage
J_{udt} Minimum area «voltage-time» which can be transferred to secondary with unipolar pulses.

n Relación de espiras
Lp Inductancia del primario
Ck Capacidad de acoplamiento entre el primario y secundarios en serie
Ls Inductancia del primario con los secundarios en corto circuito
Rp/Rs Resistencia de los bobinados
Uis Tensión de trabajo
Up Tensión de ensayo
J_{udt} Area mínima de «tensión-tiempo» transferible al secundario con impulsos unipolares.

n Windungsverhältnis
Lp Primärinduktivität
Ck Koppelkapazität zwischen der Primärwicklung und den miteinander verbundenen Sekundärwicklungen
Ls Streuinduktivität der Primärwicklung bei kurzgeschlossenen Sekundärwicklungen
Rp/Rs Wicklungswiderstand
Uis Betriebsspannung
Up Prüfspannung
J_{udt} Minimale Spannungszeitfläche, die durch einen unipolaren Puls auf die Sekundärwicklung übertragen wird.

CODICE CODE	n	J _{udt} (μVs)	I _{p rms} (mA)	L _p (mH)	L _s (μH)	C _k (pF)	R _p (mΩ)	R _s (mΩ)	U _{is} (Vac)	U _{is} / STD (Vac)	U _p (kV)	Custodia Case	Schema
TI/105 630	1:1	5	400	0,04	0,18	9	20	48	700	440 / IEC742	4,0	105	A
TI/105 645	1:1,25:1,25	5	400	0,04	0,15	10	20	60	700	440 / IEC742	4,0	105	B
TI/109 217	1:1	200	350	1,75	5	25	320	260	440	440 / IEC742	3,75	109	C
TI/109 221	1:1:1	60	500	0,30	0,8	20	70	160	500	500 / IEC742	4,4	109	B
TI/109 204	1:1:1	120	300	0,85	2	14	250	450	700	440 / IEC742	4,2	109	B
TI/109 220	1:1:1	170	300	1,85	2,5	20	410	480	440	440 / IEC950	3,1	109	B
TI/109 210	1:1:1	250	300	2,50	5	25	500	650	330	330 / IEC742	3,1	109	A
TI/109 205	1:1,3	60	300	0,22	1,2	11	120	180	700	700 / IEC742	5,0	109	C
TI/109 202	1:1,3+1,3	60	100	0,21	1,6	11	120	280	700	700 / IEC742	5,0	109	A
TI/109 215	1:1,2+1,2	150	250	1,30	3	20	430	510	500	500 / IEC950	4,0	109	B
TI/109 213	1,13:1:1	180	250	1,85	4	20	520	450	500	500 / IEC950	4,0	109	B
TI/109 214	1,4:1:1	200	250	2,15	4	20	550	400	500	500 / IEC950	4,0	109	B
TI/117 610	1:1	150	600	0,35	0,9	25	120	135	700	7000 / IEC950	4,0	117	C
TI/117 110	1:1	300	200	3,5	5	35	800	800	500	500 / IEC950	4,0	117	C
TI/117 615	1:1:1	150	600	0,35	0,6	40	120	150	700	700 / IEC950	4,0	117	D
TI/117 120	1:1:1	300	200	3,5	2,2	35	800	800	500	500 / IEC950	4,0	117	D
TI/117 147	2:1	250	400	5,80	10	25	500	250	500	500 / IEC950	4,0	117	C
TI/117 155	2:1:1	250	400	5,80	8,5	25	500	250	500	500 / IEC950	4,0	117	D
TI/117 263	3:1	200	130	1,60	3	22	160	70	500	500 / IEC950	3,2	117	L

Drive Transformers

Scatole

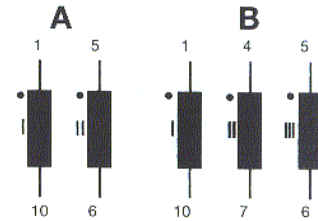
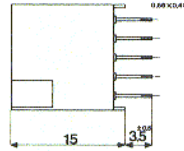
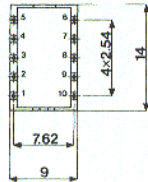
Boitiers

Cases

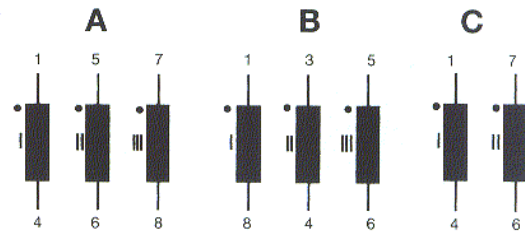
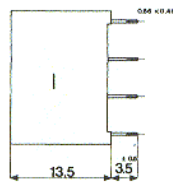
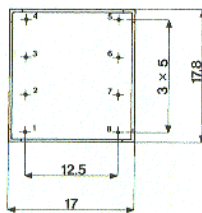
Cajas

Gehäuse

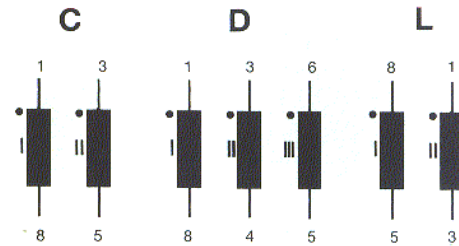
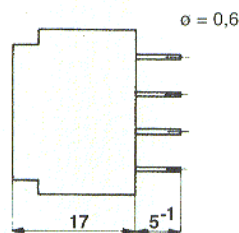
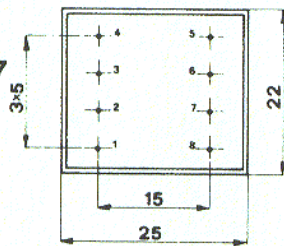
105
MODELLO
DEPOSITATO
PATENT PENDING



109
MODELLO
DEPOSITATO
PATENT PENDING



117



* Le quote sono
espresso in mm

* Les valeurs sont
exprimées en mm

* Values are in mm

*Valores expresados en
mm

* Abmessungen (mm)



35033 BRESSEO DI TEOLO (PD) - Italia - Via Selve, 2
Tel. 0039 049 9901090 - Telefax 0039 049 9901868
<http://www.sirio-ic.it> e-mail: info@sirio-ic.it